REC'D 28 OCT 2004

PCT

WIPO

BEST AVAILABLE COPY

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年10月21日

出願番号 Application Number:

特願2003-360774

[ST. 10/C]:

1:5

[JP2003-360774]

出 願 人
Applicant(s):

和光純薬工業株式会社

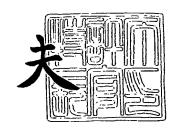
CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 6月16日





特許願 【書類名】 F-1552 【整理番号】 特許庁長官殿 【あて先】 【発明者】 和光純薬工業株式会社 化成品 埼玉県川越市大字的場1633 【住所又は居所】 研究所内 角野 元重 【氏名】 【発明者】 埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業株式会社 化成品 【住所又は居所】 研究所内 深沢 和仁 【氏名】 【発明者】 和光純薬工業株式会社 化成品 埼玉県川越市大字的場1633 【住所又は居所】 研究所内 【氏名】 今關 重明 【発明者】 和光純薬工業株式会社 東京工 埼玉県川越市大字的場1633 【住所又は居所】 場内 渡辺 哲也 【氏名】 【特許出願人】 000252300 【識別番号】 和光純薬工業株式会社 【氏名又は名称】 【代表者】 池添 太 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 006035 21,000円 【納付金額】

特許請求の範囲 1

明細書 1

要約書 1

【提出物件の目録】

【物件名】

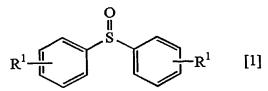
【物件名】

【物件名】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

一般式[1]



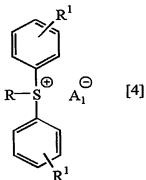
(式中、2つの R^1 は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アシル基、ヒドロキシ基、アミノ基、ニトロ基又はシアノ基を表す。) で示されるジアリールスルホキシドと一般式 [2]

RMgX [2]

(式中、Rは、ハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有していてもよいアリール基を表し、当該置換基は上記一般式 [1] に於ける R^1 で示される置換基とは異なるものであり、Xはハロゲン原子を表す。)で示されるアリールグリニャール試薬とを、当該ジアリールスルホキシドに対して3~7.5 当量の、酸素に対して親和性の高い活性化剤共存下に反応させた後、一般式 [3]

HA_1 [3]

(式中、 A_1 は強酸残基を表す。)で示される強酸又はその塩を反応させることを特徴とする、一般式 $\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$



(式中、R、 R^1 及び A_1 は前記に同じ。) で示されるトリアリールスルホニウム塩の製造法。

【請求項2】

酸素に対して親和性の高い活性化剤が、ハロゲノトリオルガノシラン、請求項1に記載の 製造法。

【請求項3】

酸素に対して親和性の高い活性化剤が、ハロゲノトリアルキルシランである、請求項1に 記載の製造法。

【請求項4】

酸素に対して親和性の高い活性化剤が、クロロトリメチルシランである、請求項1に記載の製造法。

【請求項5】

酸素に対して親和性の高い活性化剤の使用量が、一般式 [2] で示されるアリールグリニャール試薬に対して1.2~3当量である、請求項1に記載の製造法。

【請求項6】

A1 で示される強酸残基が、一般式 [5]

HX_1 [5]

(式中、 X_1 はハロゲン原子を表す。) で示されるハロゲン化水素酸、一般式 $\begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}$ R^2 - SO_3 H $\begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}$

(式中、 R^2 は、 Λ ロゲン原子を有していてもよい、アルキル基、アリール基若しくはアラルキル基又はカンファー基を表す。) で示されるスルホン酸又は一般式 [7]

HM_1Fn [7]

(式中、M1 は半金属原子を表し、nは4又は6である。)で示される無機強酸由来のアニオンである、請求項1に記載の製造法。

【請求項7】

X₁ が塩素原子又は臭素原子である、請求項6に記載の製造法。

【請求項8】

 M_1 で示される半金属原子が、ホウ素原子、リン原子、ヒ素原子又はアンチモン原子である、請求項6に記載の製造法。

【書類名】明細書

【発明の名称】トリアリールスルホニウム塩の製造法

【技術分野】

[0001]

本発明は、レジスト用酸発生剤或いは光カチオン性重合開始剤として有用な、カチオン 部の3つの芳香環のうち1つの芳香環のみ構造が異なるトリアリールスルホニウム塩の新 規製造法に関するものである。

【背景技術】

[0002]

トリアリールスルホニウム塩は、半導体製造分野のフォトリソグラフィー工程に於いて 光酸発生剤として広く用いられている。

[0003]

これらのトリアリールスルホニウム塩は、トリアリールスルホニウム ハライド (例えばクロライド、ブロマイド等。)を中間体として様々なカウンターアニオンへ容易に交換可能である。

[0004]

トリアリールスルホニウム プロマイドの合成法としては、例えば(1)ジアリールスルホキシドとGrignard試薬とを反応させる方法 (例えば非特許文献 1、非特許文献 2 等参照。)、(2)ジアリールスルホキシドと芳香族炭化水素を塩化アルミニウムの存在下で縮合反応させる方法 (例えば非特許文献 3 参照。)、(3)ジアリールジクロロスルフィドと芳香族炭化水素とを塩化アルミニウムの存在下で反応させる方法 (例えば非特許文献 4 参照。)、(4)ジアリールスルフィドとジアリールヨードニウム塩を反応させる方法 (例えば非特許文献 5 参照。)等が知られている。

[0005]

しかし、これらの方法は、例えば高温下での過酷な条件(例えば加熱還流操作、溶融反応等。)を必要とする、亜硫酸ガスを発生する、大量のアルミニウム廃液を排出する等の問題点を有している。

[0006]

そこで、ジアリールスルホキシドとアリールグリニャール試薬とを、アルキル化剤としてトリエチルオキソニウム テトラフルオロボレート(Et₃0・BF₄)を共存させることにより、穏和な条件下で反応させる方法(例えば非特許文献6参照。)が提案されている。しかし、この方法で使用されるEt₃0・BF₄は高価であるばかりか不安定な化合物であり、また人体に有害であるため操作及び取扱いが困難である等の問題点を有している。また、この方法により目的のトリアリールスルホニウム塩を合成する際に、副生成物としてカチオン部の異なる構造を有するスルホニウム塩を含むか否かについては何ら開示されていない。

[0007]

この問題を解決するために、Et₃O・BF₄の代わりに、活性化剤としてクロロトリメチルシラン (TMSC1) を共存させてトリアリールスルホニウム塩を合成する方法 (例えば特許文献 1 参照。)が提案されている。しかし、この方法はカチオン部の3つの芳香環が同一であるスルホニウム塩の合成法としては好ましいものであるが、ジアリールスルホキシド (2 つのアリール基は同じ構造を有する。)に、当該ジアリールスルホキシドのアリール基とは構造の異なるアリール基を導入する方法として利用した場合、これにより得られるスルホニウム塩の3つの芳香環の組合せとは異なる芳香環の組合せからなる2種類の副生成物が生成するという問題点を有している。

[0008]

特に、トリアリールスルホニウム塩をレジスト用酸発生剤として用いる場合には、副生成物の共存は、例えばパターン形成、感度等に影響を及ぼすため好ましくなく、しかも、これを改良するのは難しいという問題点を有している。

[0009]

このような状況下、トリアリールスルホニウム塩の3つの芳香環のうち1つの芳香環のみ異なる構造を有するトリアリールスルホニウム塩を副生成物を生ずることなく、効率よく高収率で製造し得る方法の開発が望まれている現状にある。

[0010]

【特許文献1】特許第3163615号公報

【非特許文献 1】 B.S.Wildi, S.W. Taylor and H.A. Portratz, Journal of the American Chemical Society, Vol.73, p. 1965(1951)

【非特許文献 2】 J.L.Dektar and N.P.Hacker, Journal of the American Chemical Society, Vol.112, No.16, p.6004(1990)

【非特許文献 3】 G.H. Wiegand and W.E. McEwen, The Journal of Organic chemistry, Vol. 33, No. 7, p. 2671(1968)

【非特許文献 4】 G. Dougherty and P.D. Hammond, Journal of the American Chemical Society, Vol.61, p.80(1939)

【非特許文献 5】 J.V.Crivello and J.H.W.Lam, The Journal of Organic Chemistry, Vol.43, No.15, p.3055(1978)

【非特許文献 6】 Kenneth K. Andersen and Nicholas E. Papanikolaou, Tetrahedron Letters, No. 45, p. 5445(1966)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0011]

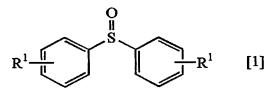
本発明は上記した如き状況に鑑みなされたもので、カチオン部の3つの芳香環のうち1つの芳香環のみが構造の異なるトリアリールスルホニウム塩(以下、本発明に係るトリアリールスルホニウム塩と略記する。)を、副生成物を生ずることなく、効率よく高収率で製造し得る方法を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

[0012]

本発明は、上記課題を解決する目的でなされたものであり、一般式 [1]

[0013]



[0014]

(式中、2つの R^1 は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アシル基、ヒドロキシ基、アミノ基、ニトロ基又はシアノ基を表す。) で示されるジアリールスルホキシドと一般式 [2]

[0015]

RMgX [2]

[0016]

(式中、Rは、ハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有していてもよいアリール基を表し、当該置換基は上記一般式 [1] に於ける R^1 とは異なるものであり、Xはハロゲン原子を表す。)で示されるアリールグリニャール試薬とを、当該ジアリールスルホキシドに対して $3\sim7$. 5 当量の、酸素に対して親和性の高い活性化剤共存下に反応させた後、一般式 [3]

[0017]

HA_1 [3]

[0018]

(式中、 A_1 は強酸残基を表す。)で示される強酸又はその塩を反応させることを特徴とする、一般式 $\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$

[0019]

(式中、R、 R^1 及び A_1 は前記に同じ。)で示されるトリアリールスルホニウム塩の製造法、の発明である。

【発明の効果】

[0021]

本発明のトリアリールスルホニウム塩の製造法は、酸素原子に対して親和性の強い活性 化剤をこれまで用いられてきた量以上に使用することにより、従来法が有していた、例え ば高温下での過酷な条件(例えば加熱還流操作、溶融反応等。)を必要とする、亜硫酸ガ スを発生する、大量のアルミニウム廃液を排出する、カチオン部の3つの芳香環が同一の スルホニウム塩しか合成できない、不純物として副生成物を含有する等の問題点を有する ことなく、効率よく高収率で目的とするスルホニウム塩を製造し得る。このような効果は 、本発明に於いて使用される酸素原子に対して親和性の高い活性化剤の使用量を大幅に増 加させることにより生じたものであり、全く予測し得ないことであった。

【発明を実施するための最良の形態】

[0022]

一般式 [1] に於いて、 \mathbb{R}^1 で示されるハロゲン原子としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられる。

[0023]

R¹ で示されるアルキル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、通常 、炭素数1~12、好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメチル基、 エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、 tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、sec-ペンチル基、tert-ペンチル基、ネ オペンチル基、2-メチルブチル基、1-エチルプロピル基、n-ヘキシル基、イソヘキシル基 、sec-ヘキシル基、tert-ヘキシル基、ネオヘキシル基、2-メチルペンチル基、1,2-ジメ チルプチル基、1-エチルブチル基、n-ヘプチル基、イソヘプチル基、sec-ヘプチル基、te rt-ヘプチル基、ネオヘプチル基、n-オクチル基、イソオクチル基、sec-オクチル基、ter t-オクチル基、ネオオクチル基、n-ノニル基、イソノニル基、sec-ノニル基、tert-ノニ ル基、ネオノニル基、n-デシル基、イソデシル基、sec-デシル基、tert-デシル基、ネオ デシル基、n-ウンデシル基、イソウンデシル基、sec-ウンデシル基、tert-ウンデシル基 、ネオウンデシル基、n-ドデシル基、イソドデシル基、sec-ドデシル基、tert-ドデシル 基、ネオドデシル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘ キシル基、シクロヘキシルメチル基、2-シクロヘキシルエチル基、シクロヘプチル基、シ クロオクチル基、シクロノニル基、シクロデシル基、シクロウンデシル基、シクロドデシ ル基等が挙げられる。

[0024]

R¹で示されるハロ低級アルキル基としては、アルキル基の水素原子の一部又は全部が

ハロゲン化 (例えばフッ素化、塩素化、臭素化、ヨウ素化等。) されたものが挙げられ、 直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、通常炭素数 1~4、好ましくは 1~2 のもの が挙げられ、具体的には、例えばフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロ メチル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロロメチル基、ブロモメチル基、 ジブロモメチル基、トリプロモメチル基、ヨードメチル基、ジヨードメチル基、トリヨー ドメチル基、ペンタフルオロエチル基、ペンタクロロエチル基、ペンタブロモエチル基、 ペンタヨードエチル基、ヘプタフルオロプロピル基、ヘプタクロロプロピル基、ヘプタブロ ロモプロピル基、ヘプタヨードプロピル基、ノナフルオロブチル基、ノナクロロブチル基 、ノナブロモブチル基、ノナヨードブチル基等が挙げられる。

[0025]

R¹で示されるアルコキシ基としては、直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、通常炭素数1~8、好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、sec-ペンチルオキシ基、tert-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、n-ヘキシルオキシ基、イソペキシルオキシ基、sec-ヘキシルオキシ基、tert-ヘキシルオキシ基、ネオヘキシルオキシ基、n-ヘプチルオキシ基、イソヘプチルオキシ基、イソヘプチルオキシ基、イソカクチルオキシ基、tert-ヘプチルオキシ基、ネオヘプチルオキシ基、ホオカクチルオキシ基、シクロプロポキシ基、シクロブトキシ基、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、シクロペプチルオキシ基、シクロオクチルオキシ基、シクロペプチルオキシ基、シクロオクチルオキシ基、シクロペプチルオキシ基、シクロオクチルオキシ基等が挙げられる。

[0026]

R¹で示されるアシル基としては、通常炭素数1~16のカルボン酸由来のものが挙げられ、具体的には、例えばホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、ヘキサノイル基、ヘプタノイル基、オクタノイル基、ノナノイル基、デカノイル基、ウンデカノイル基、ラウロイル基、ミリストイル基、パルミトイル基、シクロヘキシルカルボニル基等の脂肪族カルボン酸由来のもの、例えばベンゾイル基、ナフトイル基、トルオイル基等の芳香族カルボン酸由来のもの等が挙げられる。

[0027]

一般式 [2] に於いて、Rで示される、ハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有していてもよいアリール基のアリール基としては、通常炭素数 6~14、好ましくは6~10のものが挙げられ、具体的には、例えばフェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基等が挙げられる。

[0028]

Rで示されるハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有するアリール基の置換基として挙げられる、ハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基及びアルコキシ基としては、一般式 [1] に於ける R^1 で示されるこれらの置換基の例示と同様のものが挙げられる。

[0029]

Rで示されるハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有するアリール基の置換基として挙げられるアルキルチオ基としては、上記Rで示される置換基を有していてもよいアリール基の置換基として挙げられるアルコキシ基の酸素原子が硫黄原子で置換されたものが挙げられ、直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、通常炭素数1~8、好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、n-プチルチオ基、イソブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、tert-プチルチオ基、n-ペンチルチオ基、イソペンチルチオ基、sec-

[0030]

Rで示されるハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有するアリール基の置換基として挙げられるN-アルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基の水素原子の一部が、炭素数 $1\sim6$ の低級アルキル基で置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばN-メチルカルバモイル基、N-エチルカルバモイル基、N-n-プロピルカルバモイル基、N-イソプロピルカルバモイル基、N-n-ブチルカルバモイル基、N-イソブチルカルバモイル基、N-tert-ブチルカルバモイル基、N-ロ-ペンチルカルバモイル基、N-イソペンチルカルバモイル基、N-tert-ペンチルカルバモイル基、N-n-ペキシルカルバモイル基、N-1ペキシルカルバモイル基、N-tert-ペキシルカルバモイル基等が挙げられる。

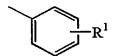
[0031]

Xで示されるハロゲン原子としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、中でも、例えばフッ素原子、塩素原子が好ましく、就中、フッ素原子がより好ましい。

[0032]

尚、一般式 [1] に於ける R^1 で示される置換基と一般式 [2] に於ける R で示される置換基を有していてもよいアリール基の置換基は異なるものである。また、一般式 [1] の部分構造である

[0033]



[0034]

と一般式 [2] に於けるRのどちらか一方がフェニル基であってもよい。

[0035]

一般式 [3] に於いて、A1 で示される強酸残基としては、一般式 [5]

[0036]

 HX_1 [5]

[0037]

(式中、 X_1 はハロゲン原子を表す。) で示されるハロゲン化水素酸由来のもの、一般式 [6]

[0038]

R^2 -SO₃H [6]

[0039]

(式中、 R^2 は、 Λ ロゲン原子を有していてもよい、アルキル基、アリール基若しくはアラルキル基又はカンファー基を表す。)で示されるスルホン酸由来のもの、一般式 [7]

[0040]

HM_1Fn [7]

[0041]

(式中、 M_1 は半金属原子を表し、n は 4 又は 6 である。)で示される無機強酸由来のもの等が挙げられる。

[0042]

一般式 [5] に於いて、 X_1 で示されるハロゲン原子としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、中でも、例えば塩素原子、臭素原子が好ましく、就中、臭素原子がより好ましい。

[0043]

一般式 [6] に於いて、R² で示される、ハロゲン原子を有していてもよいアルキル基 のアルキル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、通常炭素数1~29 、好ましくは炭素数1~18、より好ましくは炭素数1~8のものが挙げられ、具体的に は、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチ ル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、sec-ペンチル基 、tert-ペンチル基、ネオペンチル基、n-ヘキシル基、イソヘキシル基、sec-ヘキシル基 、tert-ヘキシル基、ネオヘキシル基、n-ヘプチル基、イソヘプチル基、sec-ヘプチル基 、tert-ヘプチル基、ネオヘプチル基、n-オクチル基、イソオクチル基、sec-オクチル基 、tert-オクチル基、ネオオクチル基、n-ノニル基、イソノニル基、sec-ノニル基、tert-ノニル基、ネオノニル基、n-デシル基、イソデシル基、sec-デシル基、tert-デシル基、 ネオデシル基、n-ウンデシル基、イソウンデシル基、sec-ウンデシル基、tert-ウンデシ ル基、ネオウンデシル基、n-ドデシル基、イソドデシル基、sec-ドデシル基、tert-ドデ シル基、ネオドデシル基、n-トリデシル基、イソトリデシル基、sec-トリデシル基、tert -トリデシル基、ネオトリデシル基、n-テトラデシル基、イソテトラデシル基、sec-テト ラデシル基、tert-テトラデシル基、ネオテトラデシル基、n-ペンタデシル基、イソペン タデシル基、sec-ペンタデシル基、tert-ペンタデシル基、ネオペンタデシル基、n-ヘキ サデシル基、イソヘキサデシル基、sec-ヘキサデシル基、tert-ヘキサデシル基、ネオヘ キサデシル基、n-ヘプタデシル基、イソヘプタデシル基、sec-ヘプタデシル基、tert-ヘ プタデシル基、ネオヘプタデシル基、n-オクタデシル基、イソオクタデシル基、sec-オク タデシル基、tert-オクタデシル基、ネオオクタデシル基、n-ノナデシル基、イソノナデ シル基、sec-ノナデシル基、tert-ノナデシル基、ネオノナデシル基、n-イコシル基、イ ソイコシル基、sec-イコシル基、tert-イコシル基、ネオイコシル基、n-ヘンイコシル基 、イソヘンイコシル基、sec-ヘンイコシル基、tert-ヘンイコシル基、ネオイコシル基、n -ドコシル基、イソドコシル基、sec-ドコシル基、tert-ドコシル基、ネオドコシル基、n-トリコシル基、イソトリコシル基、sec-トリコシル基、tert-トリコシル基、ネオトリコ シル基、n-テトラコシル基、イソテトラコシル基、sec-テトラコシル基、tert-テトラコ シル基、ネオテトラコシル基、n-ペンタコシル基、イソペンタコシル基、sec-ペンタコシ ル基、tert-ペンタコシル基、ネオペンタコシル基、n-ヘキサコシル基、イソヘキサコシ ル基、sec-ヘキサコシル基、tert-ヘキサコシル基、ネオヘキサコシル基、n-ヘプタコシ ル基、イソヘプタコシル基、sec-ヘプタコシル基、tert-ヘプタコシル基、ネオヘプタコ シル基、n-オクタコシル基、イソオクタコシル基、sec-オクタコシル基、tert-オクタコ シル基、ネオオクタコシル基、n-ノナコシル基、イソノナコシル基、sec-ノナコシル基、 tert-ノナコシル基、ネオノナコシル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペ ンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロデシル基、シ クロウンデシル基、シクロドデシル基、シクロトリデシル基、シクロテトラデシル基、シ クロペンタデシル基、シクロヘキサデシル基、シクロヘプタデシル基、シクロオクタデシ ル基、シクロノナデシル基、シクロイコシル基、シクロヘンイコシル基、シクロドコシル 基、シクロトリコシル基、シクロテトラコシル基、シクロペンタコシル基、シクロヘキサ コシル基、シクロヘプタコシル基、シクロオクタコシル基、シクロノナコシル基等が挙げ られる。

[0044]

 R^2 で示される、ハロゲン原子を有していてもよいアリール基のアリール基としては、通常炭素数 $6\sim1$ 6 、好ましくは炭素数 $6\sim1$ 4 のものが挙げられ、具体的には、例えばフェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、ピレニル基等が挙げられる

[0045]

 R^2 で示される、ハロゲン原子を有していてもよいアラルキル基のアラルキル基としては、通常炭素数 $7 \sim 1$ 5、好ましくは炭素数 $7 \sim 1$ 0 のものが挙げられ、具体的には、例えばベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、1-メチル-3-フェニルプロピル基、フェニルペンチル基、フェニルヘキシル基、フェニルヘプチル基、フェニルオクチル基、フェニルノニル基等が挙げられる。

[0046]

 R^2 で示される、ハロゲン原子を有する、アルキル基、アリール基及びアラルキル基とは、上記アルキル基、アリール基及びアラルキル基中の水素原子の一部又は全部がハロゲン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等。)で置換されたものである。

[0047]

具体的には、アルキル基に於いては、全ての水素原子がハロゲン原子で置換されたもの又は通常 $1 \sim 30$ 個、好ましくは $1 \sim 16$ 個の水素原子がハロゲン原子で置換されたものが挙げられ、中でも全ての水素原子がハロゲン原子で置換されたものが好ましい。

[0048]

アリール基に於いては、その環中の $1\sim5$ 個、好ましくは $3\sim5$ 個の水素原子がハロゲン原子で置換されたものが挙げられ、中でも、その環中の全ての水素原子がハロゲン原子で置換されたものが好ましい。

[0049]

アラルキル基に於いては、そのアルキル基部分の水素原子及び/又はアリール基部分の水素原子がハロゲン原子で置換されたものが挙げられ、アルキル基部分については全部又は一部の水素原子が置換されたものが含まれ、アリール基部分についてはその環中の1~5個、好ましくは5個の水素原子が置換されたものが挙げられる。

[0050]

 R^2 で示される、ハロゲン原子を有していてもよい、アルキル基、アリール基又はアラルキル基は、ハロゲン原子以外に更に置換基を有していてもよく、当該置換基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソプチル基、 sec-ブチル基、tert-ブチル基等の炭素数 $1\sim 4$ の低級アルキル基、例えばフルオロメチル基、シフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロロメチル基、ブロモメチル基、ジブロモメチル基、トリブロモメチル基、トリクロエチル基、トリカロエチル基、トリョードメチル基、トリフルオロエチル基、トリクロエチル基、トリブロモエチル基、トリョードエチル基、ペンタフルオロエチル基、ペンタフロエチル基、ペンタブロモエチル基、ペンタョードエチル基、ヘプタフルオロプロピル基、ヘプタフロプロピル基、ヘプタブロモプロピル基、ヘプタフルオロポキッ基、ノナフルオロブチル基、ノナクロロブチル基、ノナブロモブチル基、ノナヨードブチル基等の炭素数 $1\sim 4$ のハロ低級アルキル基、例えばメトキシ基、 $1\sim 4$ の氏級アルキシ基、 $1\sim 4$ の氏級アルコキシ基等が挙げられる。

[0051]

一般式 [7] に於いて、 M_1 で示される半金属原子としては、例えばホウ素原子、ケイ素原子、リン原子、ヒ素原子、アンチモン原子等が挙げられ、中でも、例えばホウ素原子、リン原子、ヒ素原子、アンチモン原子等が好ましく、就中、例えばホウ素原子、リン原子等がより好ましい。

[0052]

本発明に使用される、酸素に対して親和性の高い活性化剤としては、例えばハロゲノト リオルガノシラン、トリオルガノホスフィン、トリオルガノホスフェート等が挙げられ、 より具体的には、例えばクロロトリメチルシラン、クロロトリエチルシラン、クロロジメ チルシクロヘキシルシラン、クロロイソプロピルジメチルシラン、クロロジメチル-tert-ブチルシラン、クロロジメチル2-(2,3-ジメチル)ブチルシラン、クロロトリイソプロピル シラン、クロロジメチルフェニルシラン、ブロモトリメチルシラン等のハロゲノトリオル ガノシラン類、例えばトリフェニルホスフィン、トリn-ブチルホスフィン、トリn-ヘキシ ルホスフィン、トリn-オクチルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、ジエチルフ エニルホスフィン、ジシクロヘキシルフェニルホスフィン、メチルジフェニルホスフィン 、エチルジフェニルホスフィン、ジフェニル-n-プロピルホスフィン、イソプロピルジフ ェニルホスフィン、トリ(2-メチルフェニル)ホスフィン、トリ(3-メチルフェニル)等のト リオルガノホスフィン類、例えばトリ-n-メチルホスフェート、トリ-n-エチルホスフェー ト、トリ-n-プチルホスフェート、トリ-n-アミルホスフェート、トリ-n-オクチルホスフ エート、トリフェニルホスフェート、トリトリルホスフェート等のトリオルガノホスフェ ート類が挙げられ、中でも、ハロゲノトリアルキルシランが好ましく、就中、クロロトリ メチルシランがより好ましい。

[0053]

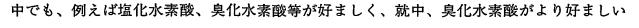
一般式 [1] で示されるジアリールスルホキシドの好ましい具体例としては、例えばジフェニルスルホキシド、ビス (4-メチルフェニル) スルホキシド、ビス (3-メチルフェニル) スルホキシド、ビス (2-メチルフェニル) スルホキシド、ビス (4-χトキシフェニル) スルホキシド、ビス (3-χトキシフェニル) スルホキシド、ビス (2-χトキシフェニル) スルホキシド、ビス (4-χトキシフェニル) スルホキシド、ビス (4-χトキンフェニル) スルホキシド、ビス (4-χトリフルオロメチルフェニル) スルホキシド、ビス (4-γ) スルホキシド等が挙げられる。

[0054]

一般式 [2] で示されるアリールグリニャール試薬の好ましい具体例としては、例えば 臭化フェニルマグネシウム、臭化4-メチルフェニルマグネシウム、臭化3-メチルフェニル マグネシウム、臭化2-メチルフェニルマグネシウム、臭化4-tert-ブチルフェニルマグネ シウム、臭化4-シクロヘキシルフェニルマグネシウム、臭化4-メトキシフェニルマグネシ ウム、臭化3-メトキシフェニルマグネシウム、臭化4-n-プトキシフェニルマグネシウム、 臭化2-n-ブトキシフェニルマグネシウム、臭化4-tert-ブトキシフェニルマグネシウム、 臭化4-シクロヘキシルオキシフェニルマグネシウム、臭化4-メチルチオフェニルマグネシ ウム、臭化2,4,6-トリメチルフェニルマグネシウム、臭化3,5-ジメチル-4-メトキシフェ ニルマグネシウム、臭化4-フルオロフェニルマグネシウム、臭化4-クロロフェニルマグネ シウム、臭化4-トリフルオロメチルフェニルマグネシウム、臭化ナフチルマグネシウム、 塩化フェニルマグネシウム、塩化4-メチルフェニルマグネシウム、塩化3-メチルフェニル マグネシウム、塩化2-メチルフェニルマグネシウム、塩化4-tert-ブチルフェニルマグネ シウム、塩化4-シクロヘキシルフェニルマグネシウム、塩化4-メトキシフェニルマグネシ ウム、塩化3-メトキシフェニルマグネシウム、塩化4-n-ブトキシフェニルマグネシウム、 塩化2-n-プトキシフェニルマグネシウム、塩化4-tert-プトキシフェニルマグネシウム、 塩化4-シクロヘキシルオキシフェニルマグネシウム、塩化4-メチルチオフェニルマグネシ ウム、塩化2,4,6-トリメチルフェニルマグネシウム、塩化3,5-ジメチル-4-メトキシフェ ニルマグネシウム、塩化4-フルオロフェニルマグネシウム、塩化4-クロロフェニルマグネ シウム、塩化4-トリフルオロメチルフェニルマグネシウム、塩化ナフチルマグネシウム等 が挙げられる。

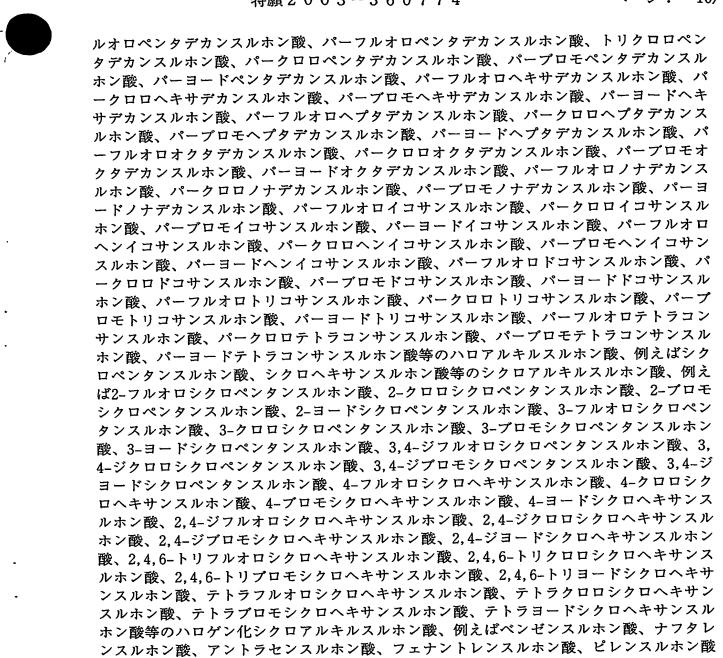
[0055]

一般式 [5] で示されるハロゲン化水素酸又はその塩の好ましい具体例としては、例えばフッ化水素酸、塩化水素酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、これらの塩(例えばリチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、ルビジウム塩、銀塩、セシウム塩等。)等が挙げられ、



[0056]

一般式「6〕で示されるスルホン酸又はその塩の好ましい具体例としては、例えばメタ ンスルホン酸、エタンスルホン酸、プロパンスルホン酸、ブタンスルホン酸、ペンタンス ルホン酸、ヘキサンスルホン酸、ヘプタンスルホン酸、オクタンスルホン酸、ノナンスル ホン酸、デカンスルホン酸、ウンデカンスルホン酸、ドデカンスルホン酸、トリデカンス ルホン酸、テトラデカンスルホン酸、ペンタデカンスルホン酸、ヘキサデカンスルホン酸 、ヘプタデカンスルホン酸、オクタデカンスルホン酸、ノナデカンスルホン酸、イコサン スルホン酸、ヘンイコサンスルホン酸、ドコサンスルホン酸、トリコサンスルホン酸、テ トラコンサンスルホン酸等のアルキルスルホン酸、例えばフルオロメタンスルホン酸、ジ フルオロメタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、クロロメタンスルホン酸、 ジクロロメタンスルホン酸、トリクロロメタンスルホン酸、ブロモメタンスルホン酸、ジ ブロモメタンスルホン酸、トリブロモメタンスルホン酸、ヨードメタンスルホン酸、ジヨ ードメタンスルホン酸、トリヨードメタンスルホン酸、フルオロエタンスルホン酸、ジフ ルオロエタンスルホン酸、トリフルオロエタンスルホン酸、ペンタフルオロエタンスルホ ン酸、クロロエタンスルホン酸、ジクロロエタンスルホン酸、トリクロロエタンスルホン 酸、ペンタクロロエタンスルホン酸、トリブロモエタンスルホン酸、ペンタブロモエタン スルホン酸、トリヨードエタンスルホン酸、ペンタヨードエタンスルホン酸、フルオロプ ロパンスルホン酸、トリフルオロプロパンスルホン酸、ヘプタフルオロプロパンスルホン 酸、クロロプロパンスルホン酸、トリクロロプロパンスルホン酸、ヘプタクロロプロパン スルホン酸、ブロモプロパンスルホン酸、トリブロモプロパンスルホン酸、ヘプタブロモ プロパンスルホン酸、トリヨードプロパンスルホン酸、ヘプタヨードプロパンスルホン酸 、トリフルオロブタンスルホン酸、ノナフルオロブタンスルホン酸、トリクロロブタンス ルホン酸、ノナクロロブタンスルホン酸、トリブロモブタンスルホン酸、ノナブロモブタ ンスルホン酸、トリヨードブタンスルホン酸、ノナヨードブタンスルホン酸、トリフルオ ロペンタンスルホン酸、パーフルオロペンタンスルホン酸、トリクロロペンタンスルホン 酸、パークロロペンタンスルホン酸、トリブロモペンタンスルホン酸、パーブロモペンタ ンスルホン酸、トリヨードペンタンスルホン酸、パーヨードペンタンスルホン酸、トリフ ルオロヘキサンスルホン酸、パーフルオロヘキサンスルホン酸、トリクロロヘキサンスル ホン酸、パークロロヘキサンスルホン酸、パーブロモヘキサンスルホン酸、パーヨードヘ キサンスルホン酸、トリフルオロヘプタンスルホン酸、パーフルオロヘプタンスルホン酸 、トリクロロヘプタンスルホン酸、パークロロヘプタンスルホン酸、パーブロモヘプタン スルホン酸、パーヨードヘプタンスルホン酸、トリフルオロオクタンスルホン酸、パーフ ルオロオクタンスルホン酸、トリクロロオクタンスルホン酸、パークロロオクタンスルホ ン酸、パーブロモオクタンスルホン酸、パーヨードオクタンスルホン酸、トリフルオロノ ナンスルホン酸、パーフルオロノナンスルホン酸、トリクロロノナンスルホン酸、パーク ロロノナンスルホン酸、パーブロモノナンスルホン酸、パーヨードノナンスルホン酸、ト リフルオロデカンスルホン酸、パーフルオロデカンスルホン酸、トリクロロデカンスルホ ン酸、パークロロデカンスルホン酸、パーブロモデカンスルホン酸、パーヨードデカンス ルホン酸、トリフルオロウンデカンスルホン酸、パーフルオロウンデカンスルホン酸、ト リクロロウンデカンスルホン酸、パークロロウンデカンスルホン酸、パーブロモウンデカ ンスルホン酸、パーヨードウンデカンスルホン酸、トリフルオロドデカンスルホン酸、パ ーフルオロドデカンスルホン酸、トリクロロドデカンスルホン酸、パークロロドデカンス ルホン酸、パーブロモドデカンスルホン酸、パーヨードドデカンスルホン酸、トリフルオ ロトリデカンスルホン酸、パーフルオロトリデカンスルホン酸、トリクロロトリデカンス ルホン酸、パークロロトリデカンスルホン酸、パーブロモトリデカンスルホン酸、パーヨ ードトリデカンスルホン酸、トリフルオロテトラデカンスルホン酸、パーフルオロテトラ デカンスルホン酸、トリクロロテトラデカンスルホン酸、パークロロテトラデカンスルホ ン酸、パープロモテトラデカンスルホン酸、パーヨードテトラデカンスルホン酸、トリフ



等の芳香族スルホン酸、例えば2-フルオロベンゼンスルホン酸、3-フルオロベンゼンスル ホン酸、4-フルオロベンゼンスルホン酸、2-クロロベンゼンスルホン酸、3-クロロベンゼ ンスルホン酸、4-クロロベンゼンスルホン酸、2-ブロモベンゼンスルホン酸、3-ブロモベ ンゼンスルホン酸、4-ブロモベンゼンスルホン酸、2-ヨードベンゼンスルホン酸、4-ヨー ドベンゼンスルホン酸、2,4-ジフルオロベンゼンスルホン酸、2,6-ジフルオロベンゼンス ルホン酸、2,4-ジクロロベンゼンスルホン酸、2,6-ジクロロベンゼンスルホン酸、2,4-ジ ブロモベンゼンスルホン酸、2,6-ジブロモベンゼンスルホン酸、2,4-ジヨードベンゼンス ルホン酸、2,6-ジョードベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリフルオロベンゼンスルホン酸、 3,4,5-トリフルオロベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリクロロベンゼンスルホン酸、3,4,5-トリクロロベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリプロモベンゼンスルホン酸、3,4,5-トリブロ モベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリヨードベンゼンスルホン酸、3,4,5-トリヨードベンゼ ンスルホン酸、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸、ペンタクロロベンゼンスルホン酸、 ペンタブロモベンゼンスルホン酸、ペンタヨードベンゼンスルホン酸、フルオロナフタレ ンスルホン酸、クロロナフタレンスルホン酸、プロモナフタレンスルホン酸、ヨードナフ タレンスルホン酸、フルオロアントラセンスルホン酸、クロロアントラセンスルホン酸、 プロモアントラセンスルホン酸、ヨードアントラセンスルホン酸等のハロゲン化芳香族ス ルホン酸、例えばp-トルエンスルホン酸、4-イソプロピルベンゼンスルホン酸、3,5-ビス (トリメチル)ベンゼンスルホン酸、3,5-ビス(イソプロピル)ベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリス(トリメチル)ベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリス(イソプロピル)ベンゼンスルホン 酸等のアルキル芳香族スルホン酸、例えば2-トリフルオロメチルベンゼンスルホン酸、2-トリクロロメチルベンゼンスルホン酸、2-トリブロモメチルベンゼンスルホン酸、2-トリ ヨードメチルベンゼンスルホン酸、3-トリフルオロメチルベンゼンスルホン酸、3-トリク ロロメチルベンゼンスルホン酸、3-トリブロモメチルベンゼンスルホン酸、3-トリヨード メチルベンゼンスルホン酸、4-トリフルオロメチルベンゼンスルホン酸、4-トリクロロメ チルベンゼンスルホン酸、4-トリブロモメチルベンゼンスルホン酸、4-トリヨードメチル ベンゼンスルホン酸、2,6-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホン酸、2,6-ビス(ト リクロロメチル)ベンゼンスルホン酸、2,6-ビス(トリブロモメチル)ベンゼンスルホン酸 、2,6-ビス(トリヨードメチル)ベンゼンスルホン酸、3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベン ゼンスルホン酸、3,5-ビス(トリクロロメチル)ベンゼンスルホン酸、3,5-ビス(トリブロ モメチル)ベンゼンスルホン酸、3.5-ビス(トリヨードメチル)ベンゼンスルホン酸等のハ ロゲン化アルキル芳香族スルホン酸、例えばベンジルスルホン酸、フェネチルスルホン酸 、フェニルプロピルスルホン酸、フェニルプチルスルホン酸、フェニルペンチルスルホン 酸、フェニルヘキシルスルホン酸、フェニルヘプチルスルホン酸、フェニルオクチルスル ホン酸、フェニルノニルスルホン酸等の芳香脂肪族スルホン酸、例えば4-フルオロフェニ ルメチルスルホン酸、4-クロロフェニルメチルスルホン酸、4-プロモフェニルメチルスル ホン酸、4-ヨードフェニルメチルスルホン酸、テトラフルオロフェニルメチルスルホン酸 、テトラクロロフェニルメチルスルホン酸、テトラブロモフェニルメチルスルホン酸、テ トラヨードフェニルメチルスルホン酸、4-フルオロフェニルエチルスルホン酸、4-クロロ フェニルエチルスルホン酸、4-ブロモフェニルエチルスルホン酸、4-ヨードフェニルエチ ルスルホン酸、4-フルオロフェニルプロピルスルホン酸、4-クロロフェニルプロピルスル ホン酸、4-ブロモフェニルプロピルスルホン酸、4-ヨードフェニルプロピルスルホン酸、 4-フルオロフェニルブチルスルホン酸、4-クロロフェニルブチルスルホン酸、4-ブロモフ ェニルブチルスルホン酸、4-ヨードフェニルブチルスルホン酸等のハロゲン化芳香脂肪族 スルホン酸、例えばカンファースルホン酸、アダマンタンカルボン酸等の脂環式スルホン 酸、これらの塩(例えばリチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、ルビジウム塩、銀塩、 セシウム塩等。) 等が挙げられる。

[0057]

一般式 [7] で示される無機強酸又はその塩の好ましい具体例としては、例えばテトラフルオロホウ酸、テトラフルオロアルミン酸、テトラフルオロ鉄酸、テトラフルオロガリウム酸、ヘキサフルオロリン酸、ヘキサフルオロヒ素酸、ヘキサフルオロアンチモン酸、ヘキサフルオロケイ素酸、ヘキサフルオロニッケル酸、ヘキサフルオロチタン酸、ヘキサフルオロジルコン酸、これらの塩(例えば銀塩、カリウム塩、ナトリウム塩、リチウム塩等。)等が挙げられる。

[0058]

一般式 [4] で示されるトリアリールスルホニウム塩は、より具体的には、例えば一般式 [8]

[0059]

$$R^1$$
 R^1 $R^$

[0065]

一般式 [8] で示されるスルホニウム塩 (ハロゲン塩) の好ましい具体例としては、例えば4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム プロマイド、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム プロマイド、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム プロマイド、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-メトキシフェニルスルホニウム ブロマイド、4-ループトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-nープトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-nープトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルスルホニウム

ert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-メチルフェニルンのフェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-メトナンフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-フルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-グロロフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-ビアロマイド、ビス(4-ビアロマイド等が挙げられる。

[0066]

―般式「9」で示されるスルホニウム塩(スルホン酸塩)の好ましい具体例としては、 例えば4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、4-メチルフ ェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、4-メチルフェニル ジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-メチルフェニルジフ ェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、3-メチルフェニルジ フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、3-メチルフェニルジフェニル スルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニ ウム パーフルオロオクタンスルホネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム p-ト リフルオロメチルベンゼンスルホネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ト リフルオロメタンスルホネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオ ロブタンスルホネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタ ンスルホネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンス ルホネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼン スルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンス ルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスル ホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスル ホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンス ルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベ ンゼンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロ メタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロ ブタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロ オクタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフル オロベンゼンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリ フルオロメチルベンゼンスルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ト リフルオロメタンスルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフル オロブタンスルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオ クタンスルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベン ゼンスルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチル ベンゼンスルホネート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタ ンスルホネート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスル ホネート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネ ート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネー ト、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホ ネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネー ト、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロプタンスルホネート、

4-n-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、4n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネー ト、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、 2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、2-n-ブ トキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、2-n-ブ トキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、 4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4 -tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、4tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、4 -tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート 、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンス ルホネート、4-tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンス ルホネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンス ルホネート、4-tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタン スルホネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベン ゼンスルホネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロ メチルベンゼンスルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム トリフル オロメタンスルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロ プタンスルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオク タンスルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベン ゼンスルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチ ルベンゼンスルホネート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム トリフル オロメタンスルホネート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム ノナフル オロブタンスルホネート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフル オロオクタンスルホネート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタ フルオロベンゼンスルホネート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニ ルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニル ジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、3,5-ジメチル-4-メトキシ フェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、3,5-ジメチル-4 -メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、3,5 -ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼン スルホネート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホ ネート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート 、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-フ ルオロフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、 4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-クロロ フェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、4-クロロフェニル ジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、4-クロロフェニルジフェ ニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-クロロフェニルジフェニル スルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、4-トリフルオロメチルフェ ニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-トリフルオロメチル フェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、4-トリフルオロメ チルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、4-トリフル オロメチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルペンゼンス ルホネート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、1-



ナフチルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、1-ナフチルジフェ ニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、1-ナフチルジフェニルスルホニ ウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム p-ト リフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム ノ ナフルオロプタンスルホネート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム パーフ ルオロオクタンスルホネート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム ペンタフ ルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム p-トリフ ルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム ノ ナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム パー フルオロオクタンスルホネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム ペン タフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスル ホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルス ルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニル スルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェ ニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス (4-トリフ ルオロメチルフェニル) フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス (4-トリフルオロメチルフェニル) フェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネ ート、ビス (4-トリフルオロメチルフェニル) フェニルスルホニウム パーフルオロオク タンスルホネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム ペン タフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスル ホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニル)フェ ニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニ ルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニル スルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニル スルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニ ルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル) フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル)フェ ニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニル スルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルス ルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルス ルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル) フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル) フェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル) フェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) フェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフ ェニル)フェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート等が挙げら れる。

[0067]

一般式 [10] で示されるスルホニウム塩(無機強酸塩)の好ましい具体例としては、 例えば4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、4-メチルフェニルジ フェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロホスフェート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサ フルオロアルセネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアン チモネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-メ チルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス (3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェ ニル ボレート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロ

フェニル)ボレート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレー ト、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガ レート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、3-メチルフェニル ジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、3-メチルフェニルジフェニルスルホ ニウム ヘキサフルオロホスフェート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキ サフルオロアルセネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロア ンチモネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス (3,5-ビス(トリフルオロメチル)フ ェニル| ボレート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオ ロフェニル)ボレート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレ ート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ガレート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、2-メチルフェニ ルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、2-メチルフェニルジフェニルスル ホニウム ヘキサフルオロホスフェート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘ キサフルオロアルセネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロ アンチモネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、 2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス (3,5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル ボレート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフル オロフェニル)ボレート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガ レート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル)ガレート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、4-tert -ブチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-tert-ブチルフェ ニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-tert-ブチルフェニルジ フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニ ルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルス ルホニウム テトラフェニルボレート、4-tert-プチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル | ボレート、4-tert-ブチルフェニ ルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-tert-ブ チルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-tert-ブチルフェニ ルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-シクロヘ キシルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、4-シクロヘキシルフェニルジ フェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニル スルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウ ム テトラフェニルボレート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム テト ラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル} ボレート、4-シクロヘキシルフェニルジ フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-シクロヘキシ ルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-シクロヘキシルフェニ ルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-メトキシ フェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、4-メトキシフェニルジフェニルスル ホニウム テトラフルオロボレート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキ サフルオロホスフェート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロ アルセネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネ ート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-メトキ シフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニ ル ボレート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロ フェニル) ボレート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレ ート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル) ガレート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、3-メトキ

シフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、3-メトキシフェニルジフ ェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、3-メトキシフェニルジフェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアルセネート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフ エニルボレート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス (3,5-ビス(ト リフルオロメチル)フェニル ボレート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テ トラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウ ム テトラフェニルガレート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス (ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パ ークロレート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート 、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-n-ブ トキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-n-ブトキシフ エニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-n-ブトキシフェニル ジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルス ルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル} ボレート、4-n-ブトキ シフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-n-ブトキシフ ェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、2-n-ブ トキシフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、2-n-ブトキシフェニルジフェ ニルスルホニウム テトラフルオロボレート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロホスフェート、2-n-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘ キサフルオロアルセネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフル オロアンチモネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボ レート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフル オロメチル)フェニル| ボレート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラ キス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス (ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロ ボレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェ ート、4-tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート 、4-tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4 -tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-tert-ブ トキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フ ェニル ボレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペン タフルオロフェニル)ボレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テト ラフェニルガレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペ ンタフルオロフェニル)ガレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パ ークロレート、4-tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレ ート、4-tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート 、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-t ert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-tert -プトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-tert-プトキシ フェニルジフェニルスルホニウム テトラキス (3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル ボレート、4-tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオ ロフェニル)ポレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニ ルガレート、4-tert-プトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフル オロフェニル) ガレート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロ レート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、 2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、2,4,

6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、2,4,6-ト リメチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、2,4,6-トリ メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルポレート、2,4,6-トリメチルフ ェニルジフェニルスルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル{ボ レート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオ ロフェニル)ボレート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェ ニルガレート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタ フルオロフェニル)ガレート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム パークロ レート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-メ チルチオフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-メチルチオ フェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-メチルチオフェニル ジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-メチルチオフェニルジフェ ニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニ ウム テトラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル | ボレート、4-メチルチオフェ ニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-メチル チオフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-メチルチオフェニル ジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、3,5-ジメチル -4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、3.5-ジメチル-4-メトキ シフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、3,5-ジメチル-4-メトキ シフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、3.5-ジメチル-4-メ トキシフェニルジフェニルスルホニウム

ヘキサフルオロアルセネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルス ルホニウム テトラフェニルボレート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルス ルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル} ボレート、3.5-ジメチ ル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ボレート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニル ガレート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペン タフルオロフェニル)ガレート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム パークロ レート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-フル オロフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-フルオロフェニ ルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-フルオロフェニルジフェニ ルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホ ニウム テトラフェニルボレート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム テトラ キス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル} ボレート、4-フルオロフェニルジフェニル スルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-フルオロフェニルジフ ェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニ ウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-クロロフェニルジフェニルスル ホニウム パークロレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロ ボレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-クロロフェニ ルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-クロロフェニルジフェニ ルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス 3.5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル ボレート、4-クロロフェニルジフェ ニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ポレート、4-クロロフェニルジ フェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニ ウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-トリフルオロメチルフェニルジ フェニルスルホニウム パークロレート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスル ホニウム テトラフルオロボレート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロホスフェート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニ

ウム ヘキサフルオロアルセネート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホ ニウム テトラフェニルボレート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウ ム テトラキス |3.5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル| ボレート、4-トリフルオロメチ ルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-トリ フルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ガレート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム パークロレート、ビス(4-メ チルフェニル) フェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、ビス(4-メチルフェニル)フェニ ルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホ ニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス |3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル| ボレート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルス ルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス(4-メチルフェニル)フ エニルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホ ニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェ ニルスルホニウム パークロレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフル オロホスフェート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロア ルセネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモ ネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、ビ ス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチ ル)フェニル ボレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ボレート、ビス(4-メトキシフェニル) フェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス (ペンタフルオロフェニル)ガレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウ ム パークロレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフル オロボレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホ スフェート、ビス(4-tert-プチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアル セネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチ モネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルボレー ト、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフ ルオロメチル)フェニル| ボレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニ ルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスル ホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、ビス (4-トリフルオロメチル フェニル) フェニルスルホニウム パークロレート、ビス (4-トリフルオロメチルフェニ ル) フェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、ビス (4-トリフルオロメチルフェ ニル) フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、ビス (4-トリフルオロメチ ルフェニル) フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ビス (4-トリフルオ ロメチルフェニル) フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ピス (4-ト リフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、ビス (4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス 3,5-ビス(トリフルオ ロメチル)フェニル ボレート、ビス (4-トリフルオロメチルフェニル) フェニルスルホニ ウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス (4-トリフルオロメチルフェ ニル) フェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス (4-トリフルオロメチルフ エニル) フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、1-ナフ チルジフェニルスルホニウム パークロレート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム テ トラフルオロボレート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェー

ト、1-ナフチルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、1-ナフチルジフ エニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、1-ナフチルジフェニルスルホニウ ム テトラフェニルボレート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム テトラキス [3,5-ビ ス(トリフルオロメチル)フェニル ボレート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム テト ラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム テトラ フェニルガレート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフ エニル)ガレート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム パークロレート、 ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、ビス(4-フ ルオロフェニル) フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、ビス (4-フルオロ フェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ビス(4-フルオロフェニ ル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4-フルオロフェニル) フェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルス ルホニウム テトラキス 3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル ボレート、ビス(4-フ ルオロフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート 、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレー ト、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム パークロレート、ビス(4-クロロフ エニル)フェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、ビス(4-クロロフェニル)フェ ニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム テト ラフェニルボレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス |3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル ボレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホ ニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニ ルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウ ム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニ ルスルホニウム パークロレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフ ルオロホスフェート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロアルセネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロア ンチモネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルボレ ート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフ ルオロメチル) フェニル| ボレート、ビス (4-ヒドロキシフェニル) フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルス ルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウ ム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート等が挙げられる。

[0068]

一般式 [4] で示されるスルホニウム塩は、例えば以下の如く製造し得る。即ち、一般式 [1] で示されるジアリールスルホキシドを、適当な溶媒に溶解させ、これに酸素原子に対して親和性の高い活性化剤(以下、本発明に係る活性化剤と略記する。)を添加し、均一な溶液とする。一方、一般式 [2] で示されるアリールグリニャール試薬を常法に従って調製し、これに先に調製した当該ジアリールスルホキシド及び本発明に係る活性化剤の均一溶液を $-78\sim50$ Cで添加した後、 $0.1\sim2$ 時間撹拌反応させる。反応終了後、得られた反応液を $0\sim50$ Cで一般式 [3] で示される強酸又はその塩と反応させることにより、一般式 [4] で示されるトリアリールスルホニウム塩が得られる。

[0069]

一般式 [1] で示されるジアリールスルホキシドは、市販品を用いてもよいし、常法 (例えばBer., 23, 1844(1890)、J. Chem. Soc. (C), 2424(1969)等参照。) により適宜製造したものを用いてもよい。

一般式 [2] で示されるアリールグリニャール試薬は、市販品を用いてもよいし、常法

ページ: 21/

により適宜製造したものを使用してもよい。

[0070]

本発明に係る活性化剤の使用量は、使用する一般式 [1] で示されるジアリールスルホ キシド、一般式 [2] で示されるアリールグリニャール試薬及び溶媒の種類によっても異 なるが、当該ジアリールスルホキシドに対して、下限が順に好ましく、3、4、4.5当 量、上限が順に好ましく、7.5、7、6当量であり、また、当該アリールグリニャール 試薬に対して、下限が順に好ましく、1.2、1.6、1.8当量、上限が順に好ましく 、3、2.8、2.4当量である。

[0071]

一般式[2]で示されるアリールグリニャール試薬の使用量は、使用する一般式[1] で示されるジアリールスルホキシド及び溶媒の種類によっても異なるが、当該ジアリール スルホキシドに対して、1.0~10当量、好ましくは2.0~5.0当量である。

[0072]

使用する反応溶媒としては、例えばエチルエーテル、イソプロピルエーテル、テトラヒ ドロフラン, ジオキサン, 1,2-ジメトキシエタン, tert-ブチルメチルエーテル, シクロ ペンチルメチルエーテル等のエーテル類、例えば塩化メチレン,臭化メチレン,1,2-ジク ロロエタン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素類、例えばベンゼン、トルエン、キシ レン等の芳香族炭化水素類等が挙げられ、これらは単独で用いても二種以上を適宜組み合 わせて用いてもよい。

[0073]

また、本発明の方法により得られたトリアリールスルホニウム塩のうち、ハロゲン塩の ものは、更に、常法(例えば国際公開第WO02/092559号公報等参照。)に従っ て、これを例えばメタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類に溶解し 、酸化銀で処理した後、1.0~5.0倍モルの各種酸を添加し、生じたハロゲン化銀を濾去し た後、アルコール類を留去し、例えば塩化メチレン、1,2-ジクロロエタン、酢酸エチル、 酢酸ブチル,プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート,メチルイソブチルケ トン、メチルエチルケトン等の有機溶媒に再び溶解する。得られた溶液を水洗した後、減 圧濃縮すれば、カウンターアニオンであるハロゲン原子が目的とする酸由来のカウンター アニオンへ置換されたトリアリールスルホニウム塩が得られる。

[0074]

また、2層系で反応を行う場合は、例えば塩化メチレン、1,2-ジクロロエタン、酢酸エ チル、酢酸ブチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、メチルイソブ チルケトン,メチルエチルケトン等の有機溶媒と水との2層系の溶媒にトリアリールスル ホニウム塩を溶解し、1.0~5.0倍モルの各種酸又はアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩 を添加し反応させる。反応終了後、得られた反応液を水洗した後減圧濃縮すれば、カウン ターアニオンであるハロゲン原子が目的とする酸由来のカウンターアニオンへ置換された トリアリールスルホニウム塩が得られる。

反応後の後処理は、この分野に於いて通常行われる後処理法に準じて行えばよい。

[0075]

本発明のトリアリールスルホニウム塩の製造法は、本発明に係る活性化剤をこれまで用 いられてきた量以上に使用することにより、従来法が有していた、例えば高温下での過酷 な条件(例えば加熱還流操作、溶融反応等。)を必要とする、亜硫酸ガスを発生する、大 量のアルミニウム廃液を排出する、カチオン部の3つの芳香環が同一のスルホニウム塩し か合成できない、不純物として副生成物を含有する等の問題点を有することなく、効率よ く高収率で本発明に係るトリアリールスルホニウム塩を製造し得る。

[0076]

また、本発明に係るトリアリールスルホニウム塩は、常法に従って目的とするアニオン 由来の化合物と反応させることにより、目的とするカウンターアニオンに交換されたトリ アリールスルホニウム塩を製造し得る。

[0077]

ページ: 22/

更に、本発明の方法により製造されたトリアリールスルホニウム塩は副生成物含量が極めて低いため、これを酸発生剤として使用した場合には、例えば超微細パターンのプロファイルや側壁の荒れを改善することができる、矩形でエッジラフネスの小さい良好なパターンが形成され得る等の効果が期待できる。

[0078]

以下、実施例及び比較例によって本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらによって何ら限定されるものではない。

【実施例】

[0079]

実施例1. 4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム プロマイドの合成

4-プロモトルエンとマグネシウムとを原料とし、テトラヒドロフラン (THF) を溶媒として常法により調製した4-メチルフェニルグリニャール試薬 1.32L (1.88mol, 1.42mol L, 2.5equiv.) にジフェニルスルホキシド 151.7lg (0.75mol, 1equiv.) とクロロトリメチルシラン 407.25g (3.75mol, 5equiv.) (TMSC1) とをTHF 0.6Lに溶解させた溶液を-5C~室温で添加した後、30分間撹拌反応させた。反応終了後、得られた反応液を12%臭化水素酸 1.1Lに注入し、ジクロロメタン 1.8Lで2回抽出した。得られた目的物を洗浄した後、濃縮乾固し、アセトン 1.8Lで結晶化することにより、目的物 203.7gを白色結晶として得た(収率 76%)。物性データを表1に示す。

[0800]

実施例2~16. 各種スルホニウム塩の合成

アリールハライドとして実施例1で使用した4-ブロモトルエンの代わりに表1~4に示す所定のアリールハライドを使用した以外は、実施例1と同様の操作を行い、目的物を得た。その結果を表1~4に示す。

[0081]

実施例17~23. 各種スルホニウム塩の合成

アリールハライドとして実施例1で使用した4-ブロモトルエンの代わりにブロモベンゼンを、スルホキシドとしてジフェニルスルホキシドの代わりに表5及び6に示す所定のスルホキシドを使用した以外は、実施例1と同様の操作を行い、目的物を得た。その結果を表5及び6に示す。

[0082]

【表1】

実施例	アリールハライト・	目的物	物性データ
1	4-7・ロモトルエン	4-メチルフェニルシ・フェ	収率: 76%; m.p.; 243.1-243.6℃; ¹H-NMR(400M
i		ニルスルホニウム フ・ロマ	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.84-7.71(12H, m, Ph), 6.73(2H,$
		1 }'	d, J=8.54Hz, Ph), 2.48(3H, s, CH3); IR(KBr)(c
			m-1)=3069, 3045, 2984, 2359, 1591, 1475, 144
			6, 1309, 1188, 1155, 1066, 995, 808, 763, 68
			6
2	3-7゚ロモトルエン	3-メチルフェニルシ・フェ	収率: 77%; m.p.: 126.7-128°C; 1H-NMR(400MHz
		ニルスルホニウム フ・ロマ	, CDCl ₃) $\delta = 7.87-7.84(4H, m, Ph), 7.82-7.72$ (6
		1 ト*	H, m. Ph), 7.64-7.57 (4H, m, Ph), 2.46(3H, s,
			CH ₃); IR(KBr)(cm ⁻¹)=3440, 3079, 3030, 1622, 1
			599, 1476, 1445, 1317, 1068, 995, 789, 767,
			750, 684
3	2-プロモトルエン	2-メチルフェニルシ フェ	収率: 64%, m.p.: 228.6-228.9°C; 1H-NMR(400M
		ニルスルホニウム フ・ロマ	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.86-7.73(10H, m, Ph), 7.68-7.6$
		11°	5 (1H, m, Ph), 7.55-7.32 (2H, m, Ph), 7.09(1H,
			$J=8.30Hz$, Ph), 2.66(3H, s, CH ₃); $IR(KBr)(cm^{-1})$
			=3476, 3404, 3077, 2993, 2338, 1591, 1476,
			1446, 1278, 1178, 1159, 1072, 995, 765, 688
4	1-7° 0 - 4-t	4-tert-プチルフェニ	収率: 79%; m.p.: 232.0-233.2°C; 1H-NMR(400M
	ert-プチルペ	ルシ・フェニルスルホニウム	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.87 - 7.70(14 \text{H}, \text{m}, \text{Ph}), 1.35(9 \text{H},)$
	ンちょン	ጋ* ¤マイト*	s, (CH ₃) ₃); IR(KBr)(cm ⁻¹)=3045, 2966, 1587, 14
		:	73, 1444, 1396, 1363, 1309, 1194, 1178, 111
			3, 1072, 995, 852, 823, 763, 688
5	1-プロモ-4-シ	4-シクロヘキシルフェニル	収率: 93%; m.p.: 232.0-233.2°C; ¹ H-NMR(400M
	クロヘキシルヘ・ンセ	シ゛フェニルスルホニウム	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.85 - 7.54(12 \text{H}, \text{m}, \text{Ph}), 7.54 - 7.5$
	*>	プ ロマイト゚	1(2H, m, Ph), 2.61(1H, dt, J=6.35Hz, J=2.44H
			z, CH), 1.95-1.81(4H, m, CH ₂), 1.76(1H, dddd,
			J-1.47Hz, J=2.68Hz, J=8.00Hz, J=13.03Hz, CH)
			, 1.30-1.19(4H, m, CH _{2¥}), 1.25(1H, dddd, J-3.1
			4Hz, J=7.20Hz, J=8.70Hz, J=25.64Hz, CH ₂); IR
			(KBr)(cm ⁻¹)=3412, 2924, 2851, 2091, 1585, 147
			5, 1444, 1410, 1327, 1186, 1111, 1068, 1022,
			997, 835, 754, 684

[0083]

【表2】

実 施 例	アリールハライト・	目的物	物性データ
6	1-プロモ-4-メ	4-メトキシフェニルシ・フ	収率: 91%; m.p.: 155.0-156.3°C; ¹ H-NMR(400M
	トキシヘ゜ンセ゜ン	ェニルスルホニウム フ・ロ	Hz, CDC1 ₃) $\delta = 7.89(2H, dd, J=1.95Hz, J=7.08H$
		71 1	z, Ph), 7.80-7.68(10H, m, Ph), 7.23(2H, dd, J=
			1.95Hz, J=7.08Hz, Ph), 3.92(3H, s, CH ₃ O); IR(K
			Br)(cm ⁻¹)=3481, 3393, 3080, 2841, 2575, 2019,
			1587, 1495, 1475, 1444, 1415, 1311, 1269, 1
			178, 1116, 1070, 1016, 939, 856, 837, 798, 7
			56, 686
7	1-7 DE-3-1	3-メトキシフェニルシ゜フ	収率: 77%; m.p.: 88.4-89.8°C; 1H-NMR(400MHz,
	トキシヘ・ンセ・ン	ェニルスルホニウム フ゜ロ	CDCl ₃) $\delta = 7.89-7.83(4H, m, Ph), 7.80-7.67(6H,$
		711	m, Ph), 7.63(1H, s, Ph), 7.59(1H, t, J=8.18Hz,
			Ph), 7.25(1H, d, J=8.18Hz, Ph), 7.21(1H, d, J
			=8.18Hz, Ph), 3.89(3H, s, CH_3O); $IR(KBr)(cm^{-1})=$
			3466, 3387, 3084, 3032, 3015, 2976, 2839, 1
			591, 1483, 1444, 1427, 1286, 1250, 1188, 10
			72, 1032, 997, 875, 785, 761, 684
8	1-7 PE-2-7	4-プトキシフェニルシ゚	収率: 78%; m.p.: 130.4-132.5°C; ¹ H-NMR(400M
	^ トキシヘ [®] ンセ [*] ン	フェニルスルホニウム フ゜	Hz, CDC1 ₃) $\delta = 7.87(2H, d, J=8.79Hz, Ph), 7.80-$
		ロ マイト*	7.68(10H, m, Ph), 7.19(2H, d, J=9.03Hz, Ph), 4
			.06(2H, t, J=6.34Hz, OCH ₂), 1.79(2H,dt, J=6.34
		•	Hz, J=21.49, CH ₂), 1.49(2H, dq, J=7.45Hz, J=2
			1.49Hz, CH ₂), 0.97(3H, t, J=7.45Hz, CH ₃); IR(K
			Br)(cm ⁻¹)= 3483, 3406, 3192, 3080, 3022, 295
			7, 2874, 2575, 1900, 1767, 1682, 1587, 1475,
			1444, 1415, 1309, 1261, 1178, 1120, 1068, 1
9	1-7 nt-4-t	4-tert-7' ++ 971	022, 999, 964, 856, 763, 688 収率: 40%; m.p.: 89.4-95.5°C; ¹ H-NMR(400MHz,
	ert-7' \+\$\%	ニルシ゜フェニルスルホニウ	CDCl ₃) $\delta = 7.86 - 7.81 \{6H, m, Ph\}, 7.74 - 7.28 \{6H, m, Ph\}$
	・クチ・ク	ል ጋ' በ የ ፈ ት '	m, Ph), 7.23(2H, d, J=9.03Hz, Ph), 1.49(9H, s
			, CH ₃); IR(KBr)(cm ⁻¹)= 3053, 2972, 2872, 1579,
			1491, 1475, 1442, 1396, 1369, 1253, 1163, 1
			068, 997, 898, 866, 765, 744, 684
			. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[0084]



【表3】

実 施 例	アリールハライト・	目的物	物性データ
10	1-7 ロモ-4-メ	4-メチルチオフェニルシ゜	収率: 83%; m.p.: 160.8-161.8°C; ¹ H-NMR(400M
	チルチオヘ・ンセ・ン	フェニルスルホニウム フ゜	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.86-7.78(6H, m, Ph), 7.76-7.69($
		ከ ፈላት,	6H, m, Ph), 7.48(2H, d, J=8.54Hz, Ph), 2.53(3
			H, s. CH ₃ S); IR(KBr)(cm ⁻¹)= 3447, 3045, 2990,
			2943, 1566, 1547, 1475, 1441, 1402, 1313, 1
			201, 1178, 1099, 1062, 997, 825, 804, 761, 7
			48, 682
1 1	1-7 NE-2,4	2,4,6-トリメチルフェ	収率: 23%; m.p.: 202.0-202.6°C; 1H-NMR(400M
	,6-トリメチルへ	ニルシ゛フェニルスルホニウ	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.80-7.76(6H, m, Ph), 7.70-7.68($
	>₽* >	ለ ጋ, ከ ፊላ ኑ ,	4H, m, Ph), 7.23(2H, s. Ph), 2.43(3H, s, CH ₃),
1			2.36(6H, s, CH ₃); IR(KBr)(cm ⁻¹)= 3449, 3387, 3
			057, 2991, 1597, 1572, 1471, 1446, 1385, 13
			00, 1172, 1039, 997, 879, 754, 686
1 2	1-7 NE-3,5	3,5-ジメチル-4-メ	収率: 84%; m.p.: 174.2-175.2°C; ¹ H-NMR(400M
	-ジ*メチル-4-メ	トキシフェニルシ゛フェニル	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.86-7.41$ (4H, m, Ph), 7.75-7.69
	トキシヘ・ンセ・ン	スルホニウム フ・ロマイト	(6H, m, Ph), 7.50(2H, s, Ph), 3.81(3H, s, OCH ₃
		·), 2.35(6H, s, CH ₃); IR(KBr)(cm ⁻¹)= 3474, 3406,
			3047, 3005, 2982, 2918, 1574, 1475, 1446, 1
			402, 1313, 1275, 1230, 1169, 1111, 1072, 99
1 3	1 7' 07 4 7	4 = 0.1 =	9, 893, 767, 752, 684
' 3	1-プロモ-4-フ ルオロペンセ゚ン	4-フルオロフェニルシ [*] フ	収率: 66%; m.p.: 222.0-223.2°C; ¹ H-NMR(400M
	ルタロペ フモ フ	ェニルスルホニウム フ゜ロ	Hz, CDC1 ₃) $\delta = 8.11-8.07(2H, m, Ph), 7.88-7.86$
		र4⊦*	4H, m, Ph), 7.79-7.69(6H, m, Ph), 7.44-7.39(2
			H, m, Ph); IR(KBr)(cm-1)= 3466, 3071, 3015, 2
			986, 1587, 1491, 1446, 1404, 1309, 1240, 11
1 4	1-プロモ-4-ク	4- ク ロロフェニルジフェ	65, 1103, 1066, 995, 844, 815, 756, 686
' -	1-2 Hf-4-2	ニルスルホニウム フ・ロマ	収率: 66%; m.p.: 221.6-222.6°C; ¹ H-NMR(400M
		ብት*	Hz, CDCl ₃) $\delta = 8.05-7.73(6H, m, Ph), 7.72-7.61($
		7.	8H, m, Ph); IR(KBr)(cm ⁻¹)= 3478, 3069, 3003,
			2953, 1570, 1475, 1446, 1400, 1313, 1282, 1
			184, 1091, 1068, 1008, 997, 933, 841, 815, 7 54, 684
L			JT, UOT

[0085]

【表4】

実 施 例	アリールハライト	目的物	物 性 データ
1 5	1-7'ロモ-4-ト	4-トリフルオロメチルフェ	収率: 72%; m.p.: 221.6-222.6°C; 1H-NMR(400M
1	りつルオロメチルへで	ニルシ・フェニルスルホニウ	Hz, CDCl ₃) $\delta = 8.18(2H, d, J=8.30Hz, Ph), 7.96$
	ン セ・ソ	የ ጋ, ۵ ይ ላ ኑ,	7.94(6H, m, Ph), 7.82-7.72(6H, m, Ph); IR(KBr)(
	}		cm-1)= 3439, 3026, 1604, 1477, 1446, 1402, 1
			325, 1176, 1134, 1060, 1010, 844, 752, 702,
			684
1 6	1-フ′ロモ-ナフタ	1-ナフチルシ フェニルス	収率: 42%; m.p.: 193.9-195.3°C; 1H-NMR(400M
	レン	みホニウム フ゛ロマイト゛	Hz, CDCl ₃) $\delta = 8.37(1H, d, J=8.06Hz, C10H7),$
			8.29(1H, d, J=8.30Hz, C ₁₀ H ₇), 8.07(1H, d, J=7
			.81Hz, C ₁₀ H ₇), 7.92-7.88(4H, m, Ph),7.83-7.67(9
1			H, m, Ph, $C_{10}H_7$), 7.48(1H, d, J=7.66Hz, $C_{10}H_7$)
ļ			; IR(KBr)(cm ⁻¹)= 3460, 3391, 3049, 1618, 1593,
			1504, 1475, 1446, 1367, 1346, 1323, 1290, 1
			265, 1165, 1070, 997, 943, 864, 806, 779, 76
L			3, 688, 661

[0086]



実施例	スルホキシト・	目的物	物性テ゚ータ			
17	ヒ・ス(4-メチルフ	ヒ ス(4-メチルフェニル)	収率: 90%; m.p.: 207.8-208.9°C; ¹ H-NMR(400M			
	ェニル)スルホキシト	フェニルスルホニウム フ゜	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.78(2H, d, J=7.81Hz, Ph), 7.73-$			
	•	ከ ፈላኑ•	7.68(7H, m, Ph), 7.48(4H, d, J=8.55Hz, Ph), 2.			
			45(6H, S, CH ₃); IR(KBr)(cm ⁻¹)= 3617, 3065, 300			
			3, 2955, 1589, 1491, 1443, 1402, 1315, 1290.			
			1186, 1124, 1068, 1014, 825, 806, 760, 688			
18	ヒ・ス(4-メトキシ	ピス(4-メトキシフェニ	収率: 94%; 無色油状物; 1H-NMR(400MHz, CDCl3)			
	フェニル)スルホキシ	ル)フェニルスルホニウム	δ=7.81(4H, d, J=8.79Hz, Ph), 7.72-7.69(5H,			
	F.	ጋ በፈላኑ	m, Ph), 7.20(4H, D, J=8.79Hz, Ph), 3.90(6H, s,			
			OCH ₃); IR(KBr)(cm ⁻¹)= 3400, 3086, 2976, 2841			
			, 2575, 1589, 1495, 1445, 1416, 1311, 1271,			
			1180, 1126, 1076, 1018, 837, 798, 752, 686			
1 9	t'ス(4-tert-	t' አ(4-tert-ፓ' ታ	収率: 91%; m.p.: 245.6-245.9°C; ¹ H-NMR(400M			
	フ゛チルフェニル)ス	ルフェニル)フェニルスルホ	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.86-7.82(6H, m, Ph), 7.76-7.71($			
	ルホキシト・	こうひ ン・ロタイト・	7H, m, Ph), 1.35(9H, s, CH ₃); $IR(KBr)(cm^{-1})=30$			
			67, 2964, 2872, 1587, 1493, 1471, 1446, 140			
			0, 1363, 1269, 1203, 1117, 1072, 1009, 997,			
			850, 837, 767, 690			
20	ヒ・ス(4-トリフル	ビス(4-トリフルオロメ	収率: 39%; m.p.: 283.9-284.8°C; ¹ H-NMR(400M			
	オロメチルフェニル)	チルフェニル)フェニルスル	Hz, CDCl ₃) $\delta = 7.87-7.85(6H, m, Ph), 7.81-7.04($			
	スルホキシト・	ホニウム フ゜ロマイト゜	7H, m, Ph); IR(KBr)(cm ⁻¹)= 3073, 3046, 2985,			
			1578, 1477, 1447, 1327, 1138, 1062, 995, 83			
			7, 769, 750, 684			
2 1	と ス(4-フルオロ	ヒ*ス(4-フルオロフェニ	収率: 72%; m.p.: 241.6-242.1°C; ¹ H-NMR(400M			
	フェニル)スルホキシ ト*	ル)フェニルスルホニウム	Hz. CDCl ₃) $\delta = 8.13-8.09(4H, m, Ph), 7.89-7.86($			
	•	ጋ° ¤የብኑ°	2H, m, Ph), 7.79-7.70(3H, m, Ph), 7.46-7.41(4			
			H, m, Ph); IR(KBr)(cm ⁻¹)=3574, 3480, 3090, 30			
			47, 3018, 2976, 1585, 1491, 1448, 1408, 130			
			0, 1240, 1163, 1105, 1070, 1008, 848, 814, 7			
2 2	ዸ *	ヒ [*] ス(4-クロロフェニル)	56, 686			
	ェニル)スルホキシト	フェニルスルホニウム フ゜	収率: 66%; m.p.: 179.3-180.4°C; ¹ H-NMR(400M			
i	**************************************	ロムイト。	Hz, CDCl ₃) $\delta = 8.02 - 7.98(3H, m, Ph), 7.92 - 7.76($			
		наль	2H, m, Ph), 7.75-7.65(8H, m, Ph); IR(KBr)(cm ⁻¹)			
			= 3069, 2984, 1570, 1475, 1446, 1394, 1309,			
			1157, 1039, 1064, 997, 829, 769, 746, 686			

【0087】 【表6】

実施例	スルホキシト・	目的物	物 性 データ
2 3	ヒ ′ ス(4 - ヒト ゚ロ キシフェニル)スルホ キシト ′	t * ス(4 - ヒト * ロキシフェニル)フェニルスルホニウム フ・ロマイト *	収率: 69%; m.p.: 252.6-253.0°C; ¹ H-NMR(400M Hz, CDCl ₃) δ=7.80-7.70(3H, m, Ph), 7.64-7.62(6H, m, Ph), 7.13-7.10(4H, m, Ph), 3.30-3.29(2 H, brd, OH); IR(KBr)(cm-¹)= 3061, 1595, 1579, 1496, 1441, 1342, 1288, 1224, 1109, 1072, 846, 744, 719, 679

[0088]

尚、実施例1~23について、副生成物の副生率を高速液体クロマトグラフィー [波長 出証特2004-3051809

ページ: 28/E

: 237nm、流速: 0.75ml/min、移動相: 6nMテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TP AH)含有水-アセトニトリル溶液 (水/アセトニトリル=13/7) (pH7.0)、測定時間: 30min] により測定した結果、副生成物の生成は見られなかった。

[0089]

比較例1及び実験例1~6. 本発明に係る活性化剤の当量関係

実施例1で使用したTMSC1の当量(5 equiv.)を下記の如き当量で使用した以外は、実施例1と同様の操作を行い、目的物である4-メチルフェニルジフェニルスルホニウムブロマイドを得た。得られた目的物、トリフェニルスルホニウムブロマイド(副生物1)及びビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウムブロマイド(副生物2)の収率を表7に示す。

[0090]

【表7】

	Grignard试泵/	TMSC1/	目的物	副生物 1	副生物 2
	シ`フェニルスルホキシト゜ (equiv.)	ジフェニルスルホキシド(equiv.)	(%)	(%)	(%)
比較例1	2.5	2.5	59	3	2
実験例1	2.5	3.0	72	2	1
実験例2	2.5	4.0	72	1	-
実験例3 (実施例1)	2.5	5.0	76	_	
実験例4	2.5	6.0	68	-	_
実験例 5	2.5	7.0	70	_	
実験例6	2.5	7.5	70	-	_

[0091]

表5の結果から明らかなように、比較例1と実験例1~6の結果を比較すると、比較例1が副生物の生成が見られ且つ目的物の収率も低いのに対して、実施例1~6は高収率且つ副生成物の副生率が極めて少ないことがわかる。特に、実験例3~6では副生成物の生成は全く見られないことが分かる。

以上の結果から、本発明に係る活性化剤をジアリールスルホキシド1当量に対して、通常3~7.5当量、好ましくは4~7当量、より好ましくは4.5~6当量使用すると、副生成物の生成が抑制されることが分かる。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 カチオン部の3つの芳香環のうち1つの芳香環のみが構造の異なるトリアリールスルホニウム塩(以下、本発明に係るトリアリールスルホニウム塩と略記する。)を、副生成物を生ずることなく、効率よく高収率で製造し得る方法を提供すること

【解决手段】

一般式[1]

$$\mathbb{R}^{1} \stackrel{\text{O}}{=} \mathbb{R}^{1} \qquad [1]$$

(式中、2つの R^1 は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アシル基、ヒドロキシ基、アミノ基、ニトロ基又はシアノ基を表す。) で示されるジアリールスルホキシドと一般式 [2]

RMgX [2]

(式中、Rは、ハロゲン原子、アルキル基、ハロ低級アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有していてもよいアリール基を表し、当該置換基は上記一般式 [1] に於ける R^1 とは異なるものであり、Xはハロゲン原子を表す。)で示されるアリールグリニャール試薬とを、当該ジアリールスルホキシドに対して $3 \sim 7$. 5 当量の、酸素に対して親和性の高い活性化剤共存下に反応させた後、一般式 [3]

HA_1 [3]

(式中、 A_1 は強酸残基を表す。)で示される強酸又はその塩を反応させることを特徴とする、一般式 $\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$

(式中、R、 R^1 及び A_1 は前記に同じ。)で示されるトリアリールスルホニウム塩の製造法。

【選択図】

なし。

特願2003-360774

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-360774

受付番号 50301745490

書類名 特許願

担当官 第一担当上席 0090

作成日 平成15年10月22日

<認定情報・付加情報>

平成15年10月21日

特願2003-360774

出願人履歴情報

識別番号

[000252300]

1. 変更年月日

1990年 8月 7日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番2号

氏 名 和光純薬工業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ EADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.